



Отделение химии и наук
о материалах Российской
Академии наук



Российское химическое общество
им. Д.И. Менделеева



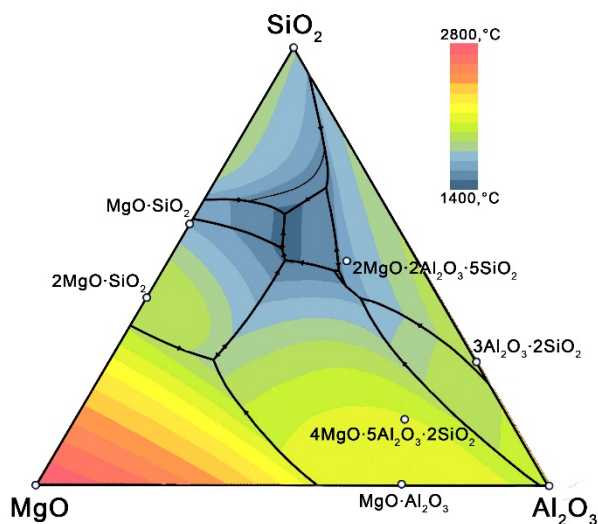
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени

Институт химии силикатов
им. И.В. Гребенщикова РАН (ИХС РАН)



*X Всероссийская конференция
(с международным участием)*
**Высокотемпературная химия
оксидных систем
и материалов,**
посвящённая 75-летию ИХС РАН



25-28 сентября 2023 года
Санкт-Петербург

О КОНФЕРЕНЦИИ:

Глубокоуважаемые коллеги!

ИХС РАН известен своими исследованиями в области неорганической и физической химии, неорганических материалов (стекло, керамика, высокотемпературные оксиды и покрытия).

Первая научная конференция по химии высокотемпературных оксидов состоялась в ИХС РАН в 1962 г. Институт продолжает традицию проведения научных конференций по этой тематике. Очередную Всероссийскую конференцию (с международным участием) «**Высокотемпературная химия оксидных систем и материалов**» планируется провести 25–28 сентября 2023 г.

На конференции планируются **пленарные** (30 минут), **устные** (15 минут) и **стендовые** доклады.

Для молодых ученых (до 35 лет) будет проведен **конкурс докладов**.

Приглашаем специалистов, молодых ученых, аспирантов и студентов принять участие в работе конференции.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Председатель – Столярова В.Л., СПбГУ, ИХС РАН, академик РАН

Зам. Председателя - Гусаров В.В., ФТИ им. А.Ф. Иоффе, ИХС РАН, чл.-корр. РАН

Уч. секретарь – Масленникова Т.П., ИХС РАН, к.х.н.

Алымов М.И., ИСМАН РАН, чл.-корр. РАН
Антипов Е.В., МГУ, чл.-корр. РАН
Бойнович Л.Б., ИФХиЭ РАН, академик РАН
Буряк А.К., ИФХиЭ РАН, чл.-корр. РАН
Василенко В.А., НИТИ им. А.П. Александрова, д.т.н.
Гавричев К.С., ИОНХ РАН, д.х.н.
Иванов В.К., ИОНХ РАН, чл.-корр. РАН
Каблов Е.Н., Президиум РАН, академик РАН
Кожевников В.Л., ИХТТ УрО РАН, академик РАН
Комлев В.С., ИМЕТ РАН, чл.-корр. РАН
Кручинина И.Ю., ИХС РАН, д.т.н.

Кузнецов С.А., ИХТЭМС КНЦ РАН, д.х.н.
Немудрый А.П., ИХТТМ СО РАН, чл.-корр. РАН
Николаев А.И., ИХТЭМС КНЦ РАН, чл.-корр. РАН
Пушаровский, Д.Ю., МГУ, академик РАН
Ремпель А.А., ИМЕТ УрО РАН, академик РАН
Русанов А.И., СПбГУ, академик РАН
Тананаев И.Г., ИХТЭМС КНЦ РАН, чл.-корр. РАН
Успенская И.А., МГУ, д.х.н.
Шевчик А.П., СПбГИ (ТУ), д.т.н.
Шейндлин М.А., ОИВТ РАН, д.ф.-м.н.
Щёкин А.К., СПбГУ, чл.-корр. РАН
Ярославцев А.Б., ИОНХ РАН, академик РАН
Паньков В.В., БГУ, Беларусь, д.х.н.
Michael I. Ojovan, Department of Materials, Imperial College London, UK, Professor
Seshadri Seetharaman, Royal Institute of Technology, Sweden, Emeritus Professor
Nguyen Anh Tien, Ho Chi Minh City University of Education, Vietnam, Professor

Программный комитет:

Председатель - Бубнова Р.С., ИХС РАН, д.х.н.

Зам. Председателя - Альмяшева О.В., СПбГЭТУ "ЛЭТИ", ИХС РАН, д.х.н.

Уч. секретарь – Мезенцева Л.П., ИХС РАН, к.х.н.

Абиев Р.Ш., СПбГИ(ТУ), д.т.н.
Баньковская И.Б., ИХС РАН, д.х.н.
Зверева И.А., СПбГУ, д.х.н.
Лопатин С.И., ИХС РАН, д.х.н.
Пантелеев И.Б., СПбГИ(ТУ), д.т.н.
Симоненко Е.П., ИОНХ РАН, д.х.н.
Тойка А.М., СПбГУ, д.х.н.
Шванская Л.В., МГУ, д.х.н.
Шилова О.А., ИХС РАН, д.х.н.

Локальный комитет:

Альмяшев В.И., НИТИ им. А.П. Александрова, к.х.н.
Беспрозванных Н.В., ИХС РАН, к.х.н.
Бирюков Я.П., ИХС РАН, к.х.н.
Ворожцов В.А., ИХС РАН, к.х.н.
Ершов Д.С., ИХС РАН, к.х.н.
Коловертнов Д.В., ИХС РАН, к.х.н.
Морозов Н.А., ИХС РАН, к.х.н.

Синельщикова О.Ю., ИХС РАН, к.х.н.
Тугова Е.А., ФТИ им. А.Ф. Иоффе, к.х.н.
Шорец О.Ю., ИХС РАН, к.г.-м.н.

Аверкиев Д.А., Белоусова О.Л., Гатина Э.Н.,
Даниелян Д.А., Коптелова Л.А., Котова М.Е.,
Лобачевская Т.С., Пугачев К.С., Тимофеева А.С.,
Цыганкова Д.И.

Место проведения конференции:

25–28 сентября 2023 г., Институт химии силикатов
им. И.В. Гребенщикова РАН, 199034, Санкт-Петербург,
наб. Макарова, д. 2.

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Фазовые равновесия оксидных систем.
Эксперимент и моделирование.
2. Кристаллохимия и функциональные и
природоподобные материалы.
3. Физико-химические свойства оксидных систем и
материалов.
4. Материалы для энергетики и аэрокосмической
отрасли. Устойчивость к окислению и
высокоэнергетическим воздействиям.

Рабочие языки - русский, английский.

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить доклад, не относящийся к тематике конференции или изменить заявленную докладчиком форму доклада.

Организационный взнос включает в себя затраты на издание трудов и информационных материалов, кофе-брейк, приветственный фуршет и составляет:

- докладчик в очном формате – 6000 рублей;
- для молодых ученых до 35 лет – 3000 рублей;
- докладчик в дистанционном формате – 2100 рублей.

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ:

15 мая 2023 г. – предварительная регистрация на сайте www.htchosm.ru

15 июня 2023 г. – представление тезисов доклада.

20 августа 2023 г. – оплата организационного взноса.

10 сентября 2023 г. – рассылка программы заседаний.

25-28 сентября 2023 г. – работа конференции.

По решению Оргкомитета избранные материалы по теме докладов после рецензирования и редактирования будут опубликованы в специальном номере **журнала «Физика и химия стекла»**.

После окончания научных заседаний конференции **28 сентября 2023 г.** запланирована культурная программа (экскурсии в музей-квартиру Д.И. Менделеева, на Императорский фарфоровый завод, в «Кунсткамеру»).

Все вопросы по работе конференции можно задать ученому секретарю программного комитета Ларисе Петровне Мезенцевой по электронной почте htchosm@mail.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ

Срок представления тезисов – **15 июня 2023 г.**

Материалы печатаются в авторской редакции.

Требования к оформлению.

- Объем до 3 страниц;
- УДК;
- Название тезисов;
- ФИО авторов;
- Институт, организация. Связь авторов и организаций отмечается цифровым знаком выноски, набираемым на верхней линии шрифта;
- Слово «Аннотация» и сам текст (объем не более 250 знаков);
- Словосочетание «Ключевые слова» и сам текст (не более 5 слов);
- Текст тезисов с включенными таблицами, рисунками и подписями к ним – 12 п. по ширине;
- Заголовок «Литература» – 12 п. жирный, по левому краю;
- Литература по ГОСТ – 10 п. по ширине;
- Сведения о финансировании курсивом с выравниванием по правому краю;
- Формат листа А4. Поля: верхнее, правое и левое – 2 см, нижнее – 2.5 см.; межстрочный интервал – одинарный. Отступ первой строки абзаца – 1.25 см;
- Шрифт текста – Times New Roman;
- Все латинские и греческие буквы в тексте, формулах (кроме индексов) и таблицах – курсив; цифры – прямые. Единицы физических величин – СИ, шрифт прямой.

Более подробная информация размещена на сайте конференции: www.htchosm.ru

Тезисы и скан экспертного заключения направляются по электронной почте по адресу: htchosm@mail.ru